

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE

N. 3597

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Richieste dei clienti

Semiconductor & Device Marketing Dept.A and Dept.B
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

Richieste dei media

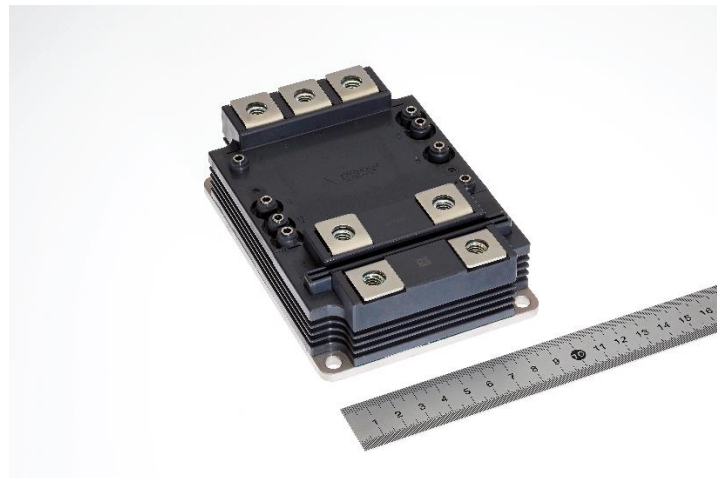
Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation

prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp

www.MitsubishiElectric.com/news/

Mitsubishi Electric inizia la fornitura di campioni del modulo SiC-MOSFET con SBD integrato

*Per sistemi inverter estremamente potenti ed efficienti utilizzati per sistemi ferroviari,
nel settore dell'energia elettrica e altro ancora*



Modulo SiC-MOSFET da 3,3 kV con SBD integrato

TOKYO, 8 maggio 2023 – [Mitsubishi Electric Corporation](https://www.mitsubishielectric.com) (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 31 maggio inizierà la spedizione di campioni di un nuovo modulo SiC-MOSFET (transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) con Schottky barrier diode (SBD) integrato, con tensione ammissibile dual-type da 3,3 kV e resistenza dielettrica di 6,0 kVrms. Si prevede che il nuovo modulo supporterà maggiore potenza, efficienza e affidabilità nei sistemi inverter per grandi apparecchiature industriali, come sistemi ferroviari e del settore dell'energia elettrica. Il prodotto sarà presentato in occasione dei principali eventi fieristici, tra i quali PCIM (Power Conversion Intelligent Motion) Europe 2023 a Norimberga, in Germania, dal 9 all'11 maggio.

Mitsubishi Electric ha già rilasciato quattro moduli Full-SiC e due moduli dual-type LV100 ad alta tensione da 3,3 kV. Per contribuire ulteriormente all'elevata potenza, all'efficienza e all'affidabilità degli inverter per grandi apparecchiature industriali, l'azienda inizierà presto a fornire campioni del suo nuovo modulo, in grado di ridurre la perdita di commutazione, ovvero un modulo SiC-MOSFET con SBD integrato e una struttura package ottimizzata.

Caratteristiche del prodotto

1) *Il modulo SiC-MOSFET con SBD integrato riduce la perdita di potenza e contribuisce alla potenza, all'efficienza e all'affidabilità*

- Il modulo SiC-MOSFET con SBD integrato e struttura del package ottimizzata riduce la perdita di commutazione del 91% rispetto al modulo di potenza in silicio esistente* e del 66% rispetto al modulo di potenza SiC esistente,** riducendo la perdita di potenza dell'inverter e contribuendo a una maggiore potenza ed efficienza.
- Il modulo SiC-MOSFET con SBD integrato e capacità di corrente ottimizzata migliora l'affidabilità dell'inverter.

2) *Layout dei terminali ottimizzato adatto a varie configurazioni e capacità degli inverter*

- Il layout ottimizzato dei terminali consente il collegamento in parallelo e supporta varie configurazioni e capacità degli inverter a seconda del numero di collegamenti in parallelo.
- La struttura del package con i terminali principali CC e CA in poli opposti contribuisce a semplificare il design dei circuiti.

Specifiche generali

Tipo	FMF800DC-66BEW
Tensione nominale	3,3 kV
Corrente nominale	800 A
Tensione di isolamento	6,0 kVrms
Collegamento	2 in 1
Dimensioni (L×P×A)	100×140×40 mm
Spedizione dei campioni	31 maggio 2023

Questo prodotto rientra nel numero elemento 2 (41)3 della Tabella 1 allegata dell'Export Trade Control Order.

I semiconduttori di potenza, che abilitano una conversione efficiente dell'energia elettrica, sono utilizzati in maniera crescente come dispositivi chiave che possono contribuire a ridurre l'impronta di carbonio della società globale, in particolare nell'industria pesante, in cui questi dispositivi vengono utilizzati in apparecchiature di conversione di potenza, come gli inverter nei sistemi di trazione ferroviari e di trasmissione CC. Le aspettative sono particolarmente alte per i semiconduttori di potenza SiC grazie alla loro capacità di ridurre significativamente le perdite di potenza. Inoltre, i moduli semiconduttori di potenza vengono utilizzati nei dispositivi di conversione di potenza nelle grandi apparecchiature industriali. La domanda di semiconduttori di potenza ad alta potenza ed efficienza sta crescendo e questo contribuisce a migliorare l'efficienza della conversione di potenza.

Sito Web

<https://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/>

###

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation

Con oltre 100 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto della produzione, del marketing e della vendita di apparecchi elettrici ed elettronici per i settori informatico e delle comunicazioni, spaziale e delle comunicazioni satellitari, dell'elettronica di consumo, delle tecnologie industriali, energetico, dei trasporti e delle costruzioni. Mitsubishi Electric utilizza la tecnologia per migliorare la società, incarnando lo spirito del concetto "Changes for the Better". L'azienda ha registrato un volume di vendite di 5.003,6 miliardi di yen (37,3 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2023. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.MitsubishiElectric.com

*Gli importi in dollari statunitensi sono convertiti in yen al tasso di cambio di ¥134 = 1 dollaro statunitense, tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2023

* Modulo di potenza in silicio da 3,3 kV/600 A (CM600DA-66X)

** Modulo di potenza Full-SiC da 3,3 kV/750 A (FMF750DC-66A)